SAMSUNG

Samsung SSD 860 QVO

Terabyte-Kapazität zum erschwinglichen Preis.



Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis

Die Samsung **SSD 860 QVO** ist die erste 4-Bit MLC (Multi-Level-Cell) SATA-SSD von Samsung mit integrierter V-NAND-Technologie und MJX-Controller. Die 4-Bit MLC-NAND-Architektur ermöglicht nicht nur mehr Speicherplatz in einer Zelle, sondern auch eine hervorragende Leistungsfähigkeit bei Alltagsanwendungen. Anwender, die eine kosteneffiziente SSD mit Terabyte-Kapazität und hoher Leistung als Ersatz für Ihre Festplatte benötigen, profitieren hier von einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis.

Starke Leistung für jeden Tag

Die **SSD 860 QVO** liefert eine sequentielle Lese- und Schreibgeschwindigkeit von bis zu 550 MB/s bzw. bis zu 520 MB/s und eine I/O-Leistung von bis zu 95.000 IOPS lesend und 89.000 IOPS schreibend. Samsung setzt zudem auf die Intelligent TurboWrite-Technologie, die Benutzer-Workloads identifiziert und einen dynamischen Puffer bereitstellt.

Bewährte Qualität und Zuverlässigkeit

Die **SSD 860 QVO** verspricht nicht nur eine umfassende Kompatibilität mit verschiedensten Systemumgebungen, sondern auch eine Lebensdauer von bis zu 1.440 TB Total Bytes Written¹, sowie eine eingeschränkte Herstellergarantie von 3 Jahren². Hinzu kommen fortschrittliche Datenverschlüsselungsverfahren wie die AES-256-Bit-Hardware-Verschlüsselung.

² Vollständige Garantiebedingungen unter: www.samsung.com/de/support/warranty/

Technische Daten







Modell			MZ-76Q1T0BW	MZ-76Q2T0BW	MZ-76Q4T0BW
Hardware Information	Kapazität¹		1 TB	2 TB	4 TB
	Größe (L x B x T)		100 x 69,9 x 6,8 mm		
	Gewicht		ca. 51 g	ca. 60 g	ca. 62 g
	Controller		Samsung MJX-Controller		
	Flash-Speicher		Samsung 4-Bit MLC V-NAND		
	DRAM Cache-Speicher		1 GB LPDDR4	2 GB LPDDR4	4 GB LPDDR4
	Formfaktor		2,5 Zoll		
Performance ²	Sequentielles Lesen		Bis zu 550 MB/s		
	Sequentielles Schreiben ³		Bis zu 520 MB/s		
	4 KB Ran. Read (QD1) ⁴		Bis zu 7.500 IOPS		
	4 KB Ran. Write (QD1) ⁴		Bis zu 42.000 IOPS		
	4 KB Ran. Read (QD32) ⁵		Bis zu 96.000 IOPS	Bis zu 97.000 IOPS	
	4 KB Ran. Write (QD32) ⁵		Bis zu 89.000 IOPS		
Energiebedarf ⁶ (typisch)	Idle DIPM eingeschaltet		30 mW		
	Bei Aktivität (durch- schnittlich)	Lesen/ Schreiben	2,1 W / 2,2 W	2,3 W / 3,1 W	
	Device Sleep ((DVSLP)	3 mW	3,5 mW	7 mW
Zulässige Spannung			5 V ± 5 %		
Zuverlässigkeit (MTBF)			1,5 Mio. Stunden		
Betriebstemperatur			0 °C bis 70 °C		
Spezifizierte Schreibdatenmenge ⁷			360 TB Total Bytes Written	720 TB Total Bytes Written	1.440 TB Total Bytes Written
Schnittstelle			SATA 6 Gb/s (abwärtskompatibel mit SATA 3 Gb/s und SATA 1,5 Gb/s)		
Stoßsicherheit			1.500 G und 0,5 ms (halber Sinus)		
Datenverschlüsselung			AES 256-Bit-Verschlüsselung (Class 0), TCG/Opal 2.0, IEEE 1667 (encrypted Drive)		
Intelligent TurboWrite Puffer-Größen			6–42 GB	6–78 GB	
Besonderheiten			TRIM (Unterstützung durch ein Betriebssystem erforderlich), Garbage Collection, S.M.A.R.T		
Garantie ⁸			3 Jahre eingeschränkte Herstellergarantie		
			l		

⁸ 3 Jahre Garantie bei gleichzeitiger Einhaltung der spezifizierten Gesamtschreibdatenmenge innerhalb der Garantiezeit: 150 TB TBW (Total Bytes Written) bei 1 TB, 360 TB TBW bei 2 TB, 720 TB TBW bei 1 TB sowie 1.440 TBW bei 4 TB. Vollständige Garantiebedingungen unter: www.samsung.com/de/support/warranty/



¹1 GB = 1.000.000.000 Bytes. Ein gewisser Anteil der Kapazität kann für Systemdateien und die Instandhaltung genutzt werden,

sodass die tatsächliche Kapazität von den Angaben auf dem Produktetikett abweichen kann.

² Die sequentielle Leistungsmessung basiert auf CrystalDiskMark v. 5.0.2. Die zufällige Leistung basiert auf IOmeter1.1.0. Die Leistung ist abhängig von der Firmware-Version, der Hardware und den Betriebseinstellungen der SSD. Testsystemeinstellung: Intel® Core i5-3550 CPU@3,3 GHz, DDR3 1333 MHz 4 GB, OS-Windows 7 Ultimate 64 Bit, Chipset-ASUS P8H77-V

³ Messwerte zur sequentiellen Schreibleistung basieren auf der Intelligent TurboWrite-Technologie. Die Leistungen außerhalb der Intelligent TurboWrite-Region liegen bei 80 MB/s (1 TB) sowie 160 MB/s (2 TB/4 TB).

Die zufälligen QD1-Leistungen außerhalb der Intelligent TurboWrite-Region liegen bei 4,4 K IOPS (1 TB/2 TB/4 TB) beim Lesen, 21 K IOPS (1 TB) 38 K IOPS (2 TB/4 TB) beim Schreiben.

⁵ Die zufälligen QD32-Leistungen außerhalb der Intelligent TurboWrite-Region liegen bei 36 K IOPS (1 TB), 60 K IOPS (2 TB/4 TB) beim Lesen, 21 K IOPS (1 TB), 40 K IOPS (2 TB), 42 K IOPS (4 TB) beim Schreiben.

⁶ Der Energiebedarf wurde gemessen mit IOmeter 1.1.0 und Intel Core i7-7700 K @ 4,2 GHz, SAMSUNG DDR4 16 GB, Gigabyte GA-ZZ70X, OS – Windows 10 PRO K x 64

⁷ Alle dokumentierten Dauerleistungstest-Ergebnisse wurden mit dem JESD218 Standard gewonnen. Detailliertere Informationen zu on JESD218 Standards finden Sie unter www.jedec.org